



6 / Priority
No.
E. Willis
5-13-02



**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 101 01 330.2

Anmeldetag: 13. Januar 2001

Anmelder/Inhaber: Philips Corporate Intellectual
Property GmbH, Hamburg/DE

Bezeichnung: Elektrische oder elektronische Schaltungsan-
ordnung und Verfahren zum Schützen der-
selben vor Manipulation und/oder Missbrauch

IPC: H 01 L, G 08 B, G 06 K

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 02. November 2001
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Weihmayer



BESCHREIBUNG

Elektrische oder elektronische Schaltungsanordnung und Verfahren zum Schützen der selben vor Manipulation und/oder vor Missbrauch

Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektrische oder elektronische Schaltungsanordnung,
5 aufweisend

- mindestens ein insbesondere schichtförmiges Trägersubstrat aus halbleitendem oder isolierendem Material;
- mindestens eine durch mindestens zwei beabstandet zueinander auf dem
10 Trägersubstrat insbesondere lithographisch aufgebrachte Leiterbahnen gebildete integrierte Schaltung,
- mindestens eine sich zwischen den Leiterbahnen und/oder lateral zu den Leiterbahnen und/oder auf den Leiterbahnen befindliche, zum Schützen der integrierten Schaltung vor äußeren Einflüssen vorgesehene dielektrische Abdeckung, insbesondere Isolierungsschicht und/oder Passivierungsschicht und/oder weitere Schutzschicht, so dass
15 die integrierte Schaltung einen spezifischen, durch die dielektrische Abdeckung bestimmten, insbesondere lateralen und/oder insbesondere parasitären Kapazitätswert aufweist.

Die Erfindung betrifft des weiteren ein Verfahren zum Schützen einer derart ausgebildeten elektrischen oder elektronischen Schaltungsanordnung vor Manipulation und/oder vor
20 Missbrauch.

Generell gilt im Zusammenhang mit Schutz vor Manipulation und/oder vor Missbrauch, dass die Sicherheitsanforderungen insbesondere auf dem Gebiet der Smart Card-Chip-technik mit wachsender Verbreitung der Smart Cards laufend zunehmen, wie etwa aus
25 dem Beispiel der Bankkarten, der Krankenkassenkarten oder auch diverser Sicherheitschipkarten ersehen werden kann. Die Gemeinsamkeit aller derartigen Chipkarten beruht auf der Speicherung sensibler Daten, die einzig und allein für den autorisierten, das heißt berechtigten Benutzer der Chipkarte im zuvor definierten Rahmen zugänglich sein sollen. In diesem Zusammenhang ist es in der Regel das Ziel unbefugter Personen, Informationen

30

aus der Chipkarte zu lesen bzw. die funktionalen Bausteine des Chips zu analysieren, um die Chipkarte missbräuchlich einsetzen zu können.

5 Eine manipulative Möglichkeit, unbefugt Informationen über den Aufbau und/oder die Funktion von Chipkarten zu erhalten, bietet das chemische oder mechanische Entfernen der dielektrischen Abdeckung, insbesondere der Passivierungsschicht, zum Zwecke der elektrischen oder elektronischen Analyse mittels Antastens der Leiterbahnen, etwa mit auf die Leiterbahnen aufzusetzenden (Mess-)Nadeln, und/oder zum Zwecke der optischen Analyse der funktionalen Bausteine mittels Mikroskop; auf diese Weise können nicht
10 zuletzt auch durch Software definierte Schranken zumindest teilweise unbefugterweise überwunden werden. Um nun die aus diesen Missbrauchsgefahren resultierenden Sicherheitsanforderungen erfüllen zu können, wird ein Konzept benötigt, das eine Kombination aus aktiven und passiven Sicherheitsstrukturen, wie etwa aus (Licht-)Sensoren und aus Passivierungsschichten, vereint.

15 Eine Anordnung der eingangs genannten Art ist nun durch die Druckschrift DE 197 38 990 A1 bekannt. Bei der in dieser Druckschrift offenbarten Einrichtung zum Schutz gegen Missbrauch einer Chipkarte werden die dielektrischen Eigenschaften einer Passivierungsschicht auf dem Chip einer Chipkarte mittels eines durch die Passivierungsschicht beeinflussten Kapazitätswertes abgetastet. Hierzu wird ein Oszillator eingesetzt,
20 dessen Schwingfrequenz durch den genannten Kapazitätswert bestimmt ist. Die aktuelle Schwingfrequenz wird mit einem Sollwert verglichen, indem ein Zähler über ein bestimmtes Zeitintervall getaktet wird und der Endzählerstand als Maß für die aktuelle Schwingfrequenz herangezogen wird.

25 Hierbei kann die vom Zähler bereitgestellte Zahl zusätzlich gemäß einem frei wählbaren Verknüpfungsalgorithmus mit einer personenspezifischen Zahl verknüpft werden, um eine weitere Zahl zu erhalten, und wahlweise kann die vom Zähler bereitgestellte Zahl oder die weitere Zahl mit einem Referenzwert verglichen werden.

30 Diese bekannte Anordnung impliziert zwar eine Reihe von Vorteilen, wie etwa die Möglichkeit, einen Missbrauch durch Chipmanipulation mittels sensibler Kapazitätsabtastung

an der Kapazitätsanordnung in der den Chip abdeckenden Schutzschicht aus Dielektrikum zu verhindern; gleichwohl entsteht der angestrebte "kapazitive Sensor" bei der Anordnung gemäß der Druckschrift DE 197 38 990 A1 erst nach Montage des zu schützenden Chips auf einer Karte mittels Aufbringens eines geeigneten Schutzlacks und ist auch nur auf diese
5 Art und Weise funktionsfähig.

Ausgehend von diesen Nachteilen und Unzulänglichkeiten der konventionellen Anordnungen liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine elektrische oder elektronische Schaltungsanordnung der eingangs genannten Art sowie ein Verfahren zum
10 Schützen einer elektrischen oder elektronischen Schaltungsanordnung vor Manipulation und/oder vor Missbrauch bereitzustellen, bei denen im Unterschied zum Stand der Technik eine vollständige Integration des angestrebten "kapazitiven Detektors" im (Halbleiter-)Chip ermöglicht ist, ohne dass - etwa über "Kontaktpads" - elektrische Verbindungen zur Außenwelt erforderlich wären und unabhängig davon, wie der (Halbleiter-)Chip letzt-
15 endlich eingesetzt wird. Des weiteren sollen durch die vorliegende Erfindung aufwendige Montagearbeiten beim eigentlichen Hersteller der Chipkarten entfallen.

Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 für eine elektrische oder elektronische Schaltungsanordnung angegebenen Merkmale sowie durch die im Anspruch 13 für ein
20 Verfahren zum Schützen einer elektrischen oder elektronischen Schaltungsanordnung vor Manipulation und/oder vor Missbrauch angegebenen Merkmale gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und zweckmäßige Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung sind in den jeweiligen Unteransprüchen gekennzeichnet.

25 Gemäß der Lehre der vorliegenden Erfindung kann durch den vorliegenden "kapazitiven Detektor", der auch als "Passivierungsschichtsensor" bezeichnet werden kann, eine manipulative Attacke auf eine durch mindestens zwei beabstandet zueinander auf einem Träger-substrat insbesondere lithographisch aufgebrachte Leiterbahnen gebildete integrierte Schaltung verhindert, zumindest jedoch erschwert werden. In diesem Zusammenhang basiert
30 das Konzept des vorliegenden "kapazitiven Detektors" oder "Passivierungsschichtsenors" auf der Ausnutzung lateraler parasitärer Kapazitäten, die sich durch die Nachbarschaft der

mindestens zwei leitenden, in bevorzugter Weise voneinander unabhängigen Leiterbahnen ergeben.

Wird nun die mindestens eine zum Schützen der integrierten Schaltung vor äußeren Einflüssen vorgesehene dielektrische Abdeckung, insbesondere in Form mindestens einer Isolierungsschicht und/oder in Form mindestens einer Passivierungsschicht und/oder in Form mindestens einer weiteren Schutzschicht, in manipulativer und/oder missbräuchlicher Absicht von einer hierzu nicht autorisierten, das heißt nicht berechtigten Person zumindest partiell entfernt, so ändert sich der relative Dielektrizitätswert der sich zwischen den Leiterbahnen und/oder lateral zu den Leiterbahnen und/oder auf den Leiterbahnen befindlichen Isolierungsschicht und/oder Passivierungsschicht und/oder weiteren Schutzschicht. Diese Änderung $\Delta\epsilon_r$ des relativen Dielektrizitätswerts führt zu einer Änderung ΔC des spezifischen Kapazitätswerts gemäß der Formel $\Delta C = \epsilon_0 \cdot \Delta\epsilon_r \cdot h \cdot l / d$, wobei durch

- $\epsilon_0 = 8,8542 \cdot 10^{-12} \text{ A s V}^{-1} \text{ m}^{-1}$ die Feldkonstante,
- h die Höhe der Leiterbahnen,
- l die Länge der Leiterbahnen und
- d der Abstand zwischen der ersten Leiterbahn und der zweiten Leiterbahn gegeben ist.

Hat mithin die Passivierungsschicht einen relativen Dielektrizitätswert $\epsilon_r = 3,9$ oder im Falle einer abdeckenden Siliziumnitritschicht gar von $\epsilon_r = 7,5$, so ändert sich dieser relative Dielektrizitätswert nach einem vollständigen Entfernen der Passivierungsschicht auf $\epsilon_{r,\text{Luft}} = 1$, das heißt die lateralen parasitären Kapazitäten, die sich durch die Nachbarschaft der mindestens zwei leitenden, in bevorzugter Weise voneinander unabhängigen Leiterbahnen ergeben, ändern sich um einen hohen Faktor.

Die Auswertung dieser Kapazitätsänderung kann als Absolutmessung oder als Relativmessung erfolgen: Wird die laterale parasitäre Kapazität in eine geeignete Oszillatorschaltung, wie etwa in eine RC-Oszillatorschaltung oder auch in eine LC-Oszillatorschaltung,

integriert, so kann durch Auswertung der Frequenzänderung infolge der Dielektrizitätsänderung gewissermaßen ein kapazitiver Sensor realisiert werden.

Eine differentielle Auswertung der vorstehend beschriebenen Kapazitätsänderung erfolgt in
5 diesem Zusammenhang in zwei Schritten:

In einem ersten Schritt wird der durch mindestens zwei zweckmäßigerweise parallele, mit mindestens einer Passivierungsschicht bedeckte "Passivierungssensor" an mindestens eine Signalerzeugungseinheit, insbesondere an mindestens eine Oszillatoreinheit, angeschlossen.
10 Die Kapazitätsänderung bewirkt hierbei eine Änderung der Oszillationsfrequenz.

In einem zweiten Schritt kommen nun mindestens zwei vorzugsweise digitale Zählereinheiten dergestalt zum Einsatz, dass eine erste Zählereinheit mit der Ausgangsfrequenz der Signalerzeugungseinheit getaktet wird, wohingegen eine zweite Zählereinheit mit einer
15 Referenzfrequenz getaktet wird. Erreicht nun die erste Zählereinheit einen bestimmten vorgegebenen Wert, so wird der Zählerstand zwischen der ersten Zählereinheit und der zweiten Zählereinheit in mindestens einer Komparatoreinheit verglichen. Im Normalfall (dielektrische Abdeckung weder chemisch noch mechanisch angegriffen, geschweige denn entfernt, das heißt dielektrische Abdeckung in Ordnung) führt der Vergleich des Zählerstands zu keiner Fehlermeldung, im Manipulations- bzw. Missbrauchsfall (dielektrische
20 Abdeckung chemisch und/oder mechanisch angegriffen oder sogar entfernt, das heißt dielektrische Abdeckung nicht in Ordnung) wird aus der infolgedessen verschobenen Frequenz eine Fehlermeldung generiert.

25 Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass durch die vorliegende Erfindung eine elektrische oder elektronische Schaltungsanordnung sowie ein Verfahren zum Schützen einer elektrischen oder elektronischen Schaltungsanordnung vor Manipulation und/oder vor Missbrauch zur Verfügung gestellt wird, bei denen - in Abgrenzung zur Einrichtung gemäß der Druckschrift DE 197 38 990 A1 - eine vollständige Integration des angestrebten
30 "kapazitiven Detektors" im (Halbleiter-)Chip ermöglicht ist, ohne dass - etwa über "Kontaktpads" - elektrische Verbindungen zur Außenwelt erforderlich sind und unabhängig davon, wie der (Halbleiter-)Chip letztendlich eingesetzt wird. Des weiteren

entfallen durch die vorliegende Erfindung aufwendige Montagearbeiten beim eigentlichen Hersteller der Chipkarten.

Ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung wird nachstehend anhand der
5 Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine durch zwei beabstandet zueinander auf einem Trägersubstrat aufgebrachte Leiterbahnen gebildete integrierte Schaltung, im Querschnitt; und

10 Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel einer Schaltungsanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung, in schematischer Prinzipdarstellung.

Gleiche oder ähnliche Ausgestaltungen, Elemente oder Merkmale sind in den Figuren 1 und 2 mit identischen Bezugszeichen versehen.

15

Die in Figur 2 dargestellte, in eine Chipkarte oder Smart Card zu implementierende und/oder zu integrierende Schaltungsanordnung 100 weist, wie aus Figur 1 im Querschnitt ersichtlich, ein schichtförmiges Trägersubstrat 10 aus halbleitendem Material einschließlich prozessierter Schaltungen und Leiterbahnen bis zur vorletzten Metallebene
20 auf. Dementsprechend ist auf dem Trägersubstrat 10 eine durch zwei mit Abstand d zueinander (Größenordnung des Abstands d :) lithographisch aufgebrachte, abschnittsweise parallel zueinander und meanderartig ineinandergreifend angeordnete Leiterbahnen 20, 25 gebildete integrierte Schaltung angeordnet, wobei zwischen den Leiterbahnen 20, 25 und lateral zu den Leiterbahnen 20, 25 eine erste dielektrische Abdeckung in Form einer
25 Passivierungsschicht 30 zum Schützen der integrierten Schaltung vor äußeren Einflüssen angeordnet ist (vgl. Figur 1).

Des weiteren ist auf den Leiterbahnen 20, 25 eine ebenfalls zum Schützen der integrierten Schaltung vor äußeren Einflüssen vorgesehene dielektrische Abdeckung in Form einer
30 weiteren Schutzschicht 35 vorgesehen, so dass die integrierte Schaltung einen spezifischen, im wesentlichen durch die beiden aus lichtundurchlässigem Material gebildeten dielek

trischen Abdeckungen 30, 35 bestimmten lateralen parasitären Kapazitätswert $C = C_{10} + C_{30} + C_{35}$ aufweist (C_{10} ist der spezifische Kapazitätswert des Träger-substrats 10).

- 5 Wird nun eine oder werden beide dielektrischen Abdeckungen in Form der Passivierungsschicht 30 und in Form der weiteren Schutzschicht 35 zumindest partiell entfernt, so ändert sich der relative Dielektrizitätswert der sich zwischen den Leiterbahnen 20, 25, lateral zu den Leiterbahnen 20, 25 und auf den Leiterbahnen 20, 25 befindlichen dielektrischen Abdeckungen.

10

Da nun an die Kontaktanschlüsse 22 bzw. 27 der Leiterbahnen 20 bzw. 25 eine Signalerzeugungseinheit 40 in Form einer Oszillatoreinheit (= Schwingkreis aus einer kapazitiven Einheit, nämlich einem Kondensator, und aus einer resistiven Einheit, nämlich einem Widerstand) angeschlossen ist, deren Ausgangsfrequenz $f_{\text{meß}}$ durch den spezifischen Kapazitätswert $C = C_{10} + C_{30} + C_{35}$ bestimmt ist, wirkt sich die durch die Änderung des

15 relativen Dielektrizitätswerts $\Delta\epsilon_r$ bedingte spezifische Kapazitätsänderung $\Delta C = \epsilon_0 \cdot \Delta\epsilon_r \cdot h / d$ unmittelbar auf die in der Signalerzeugungseinheit 40 generierte Ausgangsfrequenz $f_{\text{meß}}$ aus.

- 20 In bezug auf diese Signalerzeugungseinheit 40 in Form der RC-Oszillatoreinheit wird gewährleistet, dass die Signalerzeugungseinheit 40 in einem breiten Spannungs- und Temperaturbereich bei niedrigem Stromverbrauch sicher arbeitet.

Als Referenzfrequenz f_{ref} kann die zum Betrieb des Chips notwendige Systemfrequenz

25 benutzt werden. Eine weitere Möglichkeit bietet die Benutzung eines zusätzlichen Oszillators, dessen Aufbau dem Oszillator der Messfrequenz identisch ist, dessen frequenzbestimmenden Elemente allerdings in einer anderen Isolatorschicht untergebracht sind.

Ein wesentlicher Vorteil der Signalerzeugungseinheit 40 in Form der RC-Oszillatoreinheit

30 ist in dem großen Spannungs- und Temperaturbereich zu sehen, in dem die RC-Oszillatoreinheit arbeitet. Entfernt man den vorliegenden "kapazitiven Detektor", der auch als

"Passivierungsschichtsensor" bezeichnet werden kann, so bricht nicht etwa die Oszillation ab oder schwingt mit unendlich großer Frequenz, sondern erhöht sich lediglich auf ein Mehrfaches der vorherigen Normalfrequenz.

- 5 Der Signalerzeugungseinheit 40 ist eine erste, mit der Ausgangsfrequenz $f_{\text{meß}}$ der Signalerzeugungseinheit 40 getaktete digitale Zählereinheit 50 nachgeschaltet (vgl. Figur 2), in der nach einer vorgegebenen zeitlichen Zählperiode ein Istwert-Zählerstand ermittelbar ist. Des weiteren ist in der Schaltungsanordnung 100 eine zweite, mit einer Referenzfrequenz f_{ref} getaktete digitale Zählereinheit 55 vorgesehen, in der nach der vorgegebenen zeitlichen
- 10 Zählperiode ein Sollwert-Zählerstand ermittelbar ist.

- In der der ersten Zählereinheit 50 und der zweiten Zählereinheit 55 nachgeschalteten Komparatoreinheit 60 wird dann der Istwert-Zählerstand mit dem Sollwert-Zählerstand verglichen, wobei die Funktionen der integrierten Schaltung bei Vorliegen einer beim
- 15 Vergleichen des Istwert-Zählerstands mit dem Sollwert-Zählerstand auftretenden Fehlermeldung vorübergehend oder dauernd blockierbar und/oder sperrbar und/oder unterbrechbar sind (--> Symbol "-" in Figur 2; bei Ausbleiben einer Fehlermeldung: Symbol "+" in Figur 2), denn in diesem Falle liegt infolge eines manipulativen und/oder missbräuchlichen Angriffs auf die abdeckenden Dielektrika gemäß den vorstehend beschriebenen
- 20 Zusammenhängen eine

Änderung des relativen Dielektrizitätswerts, das heißt eine Kapazitätsänderung, das heißt eine Frequenzverschiebung vor.

- 25 Wie Figur 2 ebenfalls entnehmbar ist, ist durch die erste Zählereinheit 50, durch die zweite Zählereinheit 55 und durch die Komparatoreinheit 60 eine differentielle Auswerteeinheit 70 gebildet. Diese differentielle Auswerteeinheit 70 ist demzufolge zum Feststellen der durch ein zumindest partielles Entfernen der dielektrischen Abdeckungen 30, 35 bedingten Änderung des spezifischen Kapazitätswerts C ausgelegt, wobei die Auswerteeinheit 70
- 30 die Fehlermeldung im speziellen dann generiert, wenn der Istwert vom Sollbereich abweicht.

Zur praktischen Realisierung der Schaltungsanordnung 100 gemäß der vorliegenden Erfindung sei abschließend noch angemerkt, dass die Größe des spezifischen Kapazitätswerts C von der angestrebten Oszillatorfrequenz $f_{\text{meß}}$ abhängig ist, wobei die Berechnung des lateralen parasitären Kapazitätswerts C auf dem in den Figuren 1 und 2 angedeuteten
5 Ersatzschaltbild basiert. So hat sich beispielhaft gezeigt, dass sich im Layout bei Abständen d der Leiterbahnen 20, 25 von etwa zwei Mikrometern eine laterale Kapazität von etwa $29,7 \cdot 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ ergibt.

10

15

20

25

30

Bezugszeichenliste

	100	elektrische oder elektronische Schaltungsanordnung
5	10	Trägersubstrat
	20	erste Leiterbahn
	22	Kontaktanschluss der ersten Leiterbahn 20
	25	zweite Leiterbahn
	27	Kontaktanschluss der zweiten Leiterbahn 25
10	30	erste dielektrische Abdeckung, insbesondere Passivierungsschicht
	35	zweite dielektrische Abdeckung, insbesondere weitere Schutzschicht
	40	Signalerzeugungseinheit, insbesondere Oszillatoreinheit
15	50	erste Zählereinheit
	55	zweite Zählereinheit
	60	Komparatoreinheit
	70	Auswerteeinheit
20	C	spezifischer Kapazitätswert
	ΔC	Änderung des spezifischen Kapazitätswerts
	C_{10}	spezifischer Kapazitätswert des Trägersubstrats 10
	C_{30}	spezifischer Kapazitätswert der ersten dielektrischen Abdeckung 30
	C_{35}	spezifischer Kapazitätswert der zweiten dielektrischen Abdeckung 35
25	d	Abstand zwischen der ersten Leiterbahn 20 und der zweiten Leiterbahn 25
	ϵ_0	Feldkonstante ($\epsilon_0 = 8,8542 \cdot 10^{-12} \text{ A s V}^{-1} \text{ m}^{-1}$)
	ϵ_r	relativer Dielektrizitätswert
	$\Delta \epsilon_r$	Änderung des relativen Dielektrizitätswerts
	$f_{\text{meß}}$	Ausgangsfrequenz der Signalerzeugungseinheit 40
30	f_{ref}	Referenzfrequenz

l Länge der Leiterbahnen 20, 25

SiNO_2 Siliziumnitrit

SiO_2 Siliziumdioxid

5

PATENTANSPRÜCHE

1. Elektrische oder elektronische Schaltungsanordnung (100), aufweisend
- mindestens ein insbesondere schichtförmiges Trägersubstrat (10) aus halbleitendem oder isolierendem Material;
 - mindestens eine durch mindestens zwei beabstandet zueinander auf dem Trägersubstrat (10) insbesondere lithographisch aufgebrachte Leiterbahnen (20, 25) gebildete integrierte Schaltung,
 - mindestens eine sich zwischen den Leiterbahnen (20, 25) und/oder lateral zu den Leiterbahnen (20, 25) und/oder auf den Leiterbahnen (20, 25) befindliche, zum Schützen der integrierten Schaltung vor äußeren Einflüssen vorgesehene dielektrische Abdeckung (30; 35), insbesondere Isolierungsschicht und/oder Passivierungsschicht (30) und/oder weitere Schutzschicht (35), so dass die integrierte Schaltung einen spezifischen, durch die dielektrische Abdeckung (30; 35) bestimmten, insbesondere lateralen und/oder insbesondere parasitären Kapazitätswert (C) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
- 15 dass an die Kontaktanschlüsse (22, 27) der integrierten Schaltung mindestens eine Signalerzeugungseinheit (40), insbesondere mindestens eine Oszillatoreinheit, angeschlossen ist, deren Ausgangsfrequenz ($f_{\text{meß}}$) im wesentlichen durch den spezifischen Kapazitätswert (C) bestimmt ist,
- dass der Signalerzeugungseinheit (40) mindestens eine erste, mit der Ausgangsfrequenz ($f_{\text{meß}}$) der Signalerzeugungseinheit (40) getaktete Zählereinheit (50) nachgeschaltet ist, in der nach einer vorgegebenen zeitlichen Zählperiode ein Istwert-Zählerstand ermittelbar ist,
- 20

- dass mindestens eine zweite, mit einer Referenzfrequenz (f_{ref}) getaktete Zählereinheit (55) vorgesehen ist, in der nach der vorgegebenen zeitlichen Zählperiode ein Sollwert-Zählerstand ermittelbar ist,
 - dass der ersten Zählereinheit (50) und der zweiten Zählereinheit (55) mindestens
- 5 eine Komparatoreinheit (60) zum Vergleichen des Istwert-Zählerstands mit dem Sollwert-Zählerstand nachgeschaltet ist, wobei die Funktionen der integrierten Schaltung bei Vorliegen einer beim Vergleichen des Istwert-Zählerstands mit dem Sollwert-Zählerstand auftretenden Fehlermeldung vorübergehend oder dauernd blockierbar und/oder sperrbar und/oder unterbrechbar sind.
- 10 2. Schaltungsanordnung (100) gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leiterbahnen (20, 25) zumindest abschnittsweise parallel zueinander und/oder meanderartig ineinandergreifend angeordnet sind.
- 15 3. Schaltungsanordnung (100) gemäß Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Abstand (d) der Leiterbahnen (20, 25) zueinander im Mikrometerbereich liegt.
- 20 4. Schaltungsanordnung (100) gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Material der dielektrischen Abdeckung (30; 35) Epoxidharz oder Siliziumnitrit (SiNO_2) oder Siliziumdioxid (SiO_2) aus Epoxidharz oder Siliziumnitrit (SiNO_2) oder Siliziumdioxid (SiO_2) oder anderen in der Halbleiterfertigung verwendeten Isolator-
- 25 schichten besteht.
5. Schaltungsanordnung (100) gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Material der dielektrischen Abdeckung (30; 35) auch lichtundurchlässig
- 30 ausgebildet ist.

6. Schaltungsanordnung (100) gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Signalerzeugungseinheit (40)

- mindestens einen Schwingkreis aus mindestens einer kapazitiven Einheit,
5 insbesondere Kondensator, und aus mindestens einer resistiven Einheit,
insbesondere Widerstand, und/oder
- mindestens einen Schwingkreis aus mindestens einer kapazitiven Einheit,
insbesondere Kondensator, und aus mindestens einer induktiven Einheit,
insbesondere Spule,
10 aufweist.

7. Schaltungsanordnung (100) gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,

- dass durch die erste Zählereinheit (50), durch die zweite Zählereinheit (55) und durch die
15 Komparatoreinheit (60) mindestens eine Auswerteeinheit (70), insbesondere mindestens
eine differentielle Auswerteeinheit, gebildet ist.

8. Schaltungsanordnung (100) gemäß Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,

- 20 dass die Auswerteeinheit (70) zum Feststellen einer durch ein zumindest partielles Ent-
fernen der dielektrischen Abdeckung (30; 35) bedingten Änderung des spezifischen
Kapazitätswerts (C) ausgelegt ist.

9. Schaltungsanordnung (100) gemäß Anspruch 7 oder 8,
25 dadurch gekennzeichnet,

dass die Auswerteeinheit (70) die Fehlermeldung generiert, wenn der Istwert vom
Sollbereich abweicht.

10. Schaltungsanordnung (100) gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Zählereinheit (50) und/oder die zweite Zählereinheit (55) auf digitaler Basis
ausgebildet sind.

5

11. Schaltungsanordnung (100) gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Zählereinheit (50) und/oder die zweite Zählereinheit (55) auf digitaler Basis
ausgebildet sind.

10

12. Karte, insbesondere Chipkarte oder Smart Card, aufweisend mindestens eine elek-
trische oder elektronische Schaltungsanordnung (100) gemäß mindestens einem der
Ansprüche 1 bis 11.

15 13. Verfahren zum Schützen einer gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ausgebildeten
elektrischen oder elektronischen Schaltungsanordnung (100) vor Manipulation und/oder
vor Missbrauch,

dadurch gekennzeichnet,

dass in mindestens einer Signalerzeugungseinheit (40), insbesondere in mindestens
20 einer Oszillatoreinheit, eine durch den spezifischen Kapazitätswert (C) bestimmte
Ausgangsfrequenz ($f_{\text{meß}}$) generiert wird;

- dass in mindestens einer ersten, mit der Ausgangsfrequenz ($f_{\text{meß}}$) der Signal-
erzeugungseinheit (40) getakteten Zählereinheit (50) nach einer vorgegebenen
zeitlichen Zählperiode ein Istwert-Zählerstand ermittelt wird;

25 - dass in mindestens einer zweiten, mit einer Referenzfrequenz (f_{ref}) getakteten
Zählereinheit (55) nach der vorgegebenen zeitlichen Zählperiode ein Sollwert-Zählerstand
ermittelt wird;

dass der Istwert-Zählerstand mit dem Sollwert-Zählerstand verglichen wird; und

30 - dass die Funktionen der integrierten Schaltung vorübergehend oder dauernd
blockiert und/oder gesperrt und/oder unterbrochen werden, wenn beim

Vergleichen des Istwert-Zählerstands mit dem Sollwert-Zählerstand in mindestens einer Komparatoreinheit (60) eine Fehlermeldung auftritt.

14. Verfahren gemäß Anspruch 13,

5 dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens eine durch die erste Zählereinheit (50), durch die zweite Zählereinheit (55) und durch die Komparatoreinheit (60) gebildete Auswerteeinheit (70) auf differentieller Basis arbeitet.

10 15. Verfahren gemäß Anspruch 14,

dadurch gekennzeichnet,

dass in der Auswerteeinheit (70) eine durch ein zumindest partielles Entfernen der dielektrischen Abdeckung (30; 35) bedingte Änderung des spezifischen Kapazitätswerts (C) festgestellt wird.

15

16. Verfahren gemäß Anspruch 14 oder 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass in der Auswerteeinheit (70) die Fehlermeldung generiert wird, wenn der Istwert vom Sollbereich abweicht.

20

ZUSAMMENFASSUNG

Elektrische oder elektronische Schaltungsanordnung und Verfahren zum Schützen der selben vor Manipulation und/oder vor Missbrauch

Um eine elektrische oder elektronische Schaltungsanordnung (100), zu schaffen wird
5 vorgeschlagen,

- dass an die Kontaktanschlüsse (22, 27) der integrierten Schaltung mindestens eine Signalerzeugungseinheit (40), insbesondere mindestens eine Oszillatoreinheit, angeschlossen ist, deren Ausgangsfrequenz ($f_{\text{meß}}$) im wesentlichen durch den spezifischen Kapazitätswert (C) bestimmt ist,
- 10 - dass der Signalerzeugungseinheit (40) mindestens eine erste, mit der Ausgangsfrequenz ($f_{\text{meß}}$) der Signalerzeugungseinheit (40) getaktete Zählereinheit (50) nachgeschaltet ist, in der nach einer vorgegebenen zeitlichen Zählperiode ein Istwert-Zählerstand ermittelbar ist,
- dass mindestens eine zweite, mit einer Referenzfrequenz (f_{ref}) getaktete Zählereinheit (55) vorgesehen ist, in der nach der vorgegebenen zeitlichen Zählperiode ein Sollwert-Zählerstand ermittelbar ist,
- 15 - dass der ersten Zählereinheit (50) und der zweiten Zählereinheit (55) mindestens eine Komparatoreinheit (60) zum Vergleichen des Istwert-Zählerstands mit dem Sollwert-Zählerstand nachgeschaltet ist, wobei die Funktionen der integrierten
- 20 Schaltung bei Vorliegen einer beim Vergleichen des Istwert-Zählerstands mit dem Sollwert-Zählerstand auftretenden Fehlermeldung vorübergehend oder dauernd blockierbar und/oder sperrbar und/oder unterbrechbar sind.

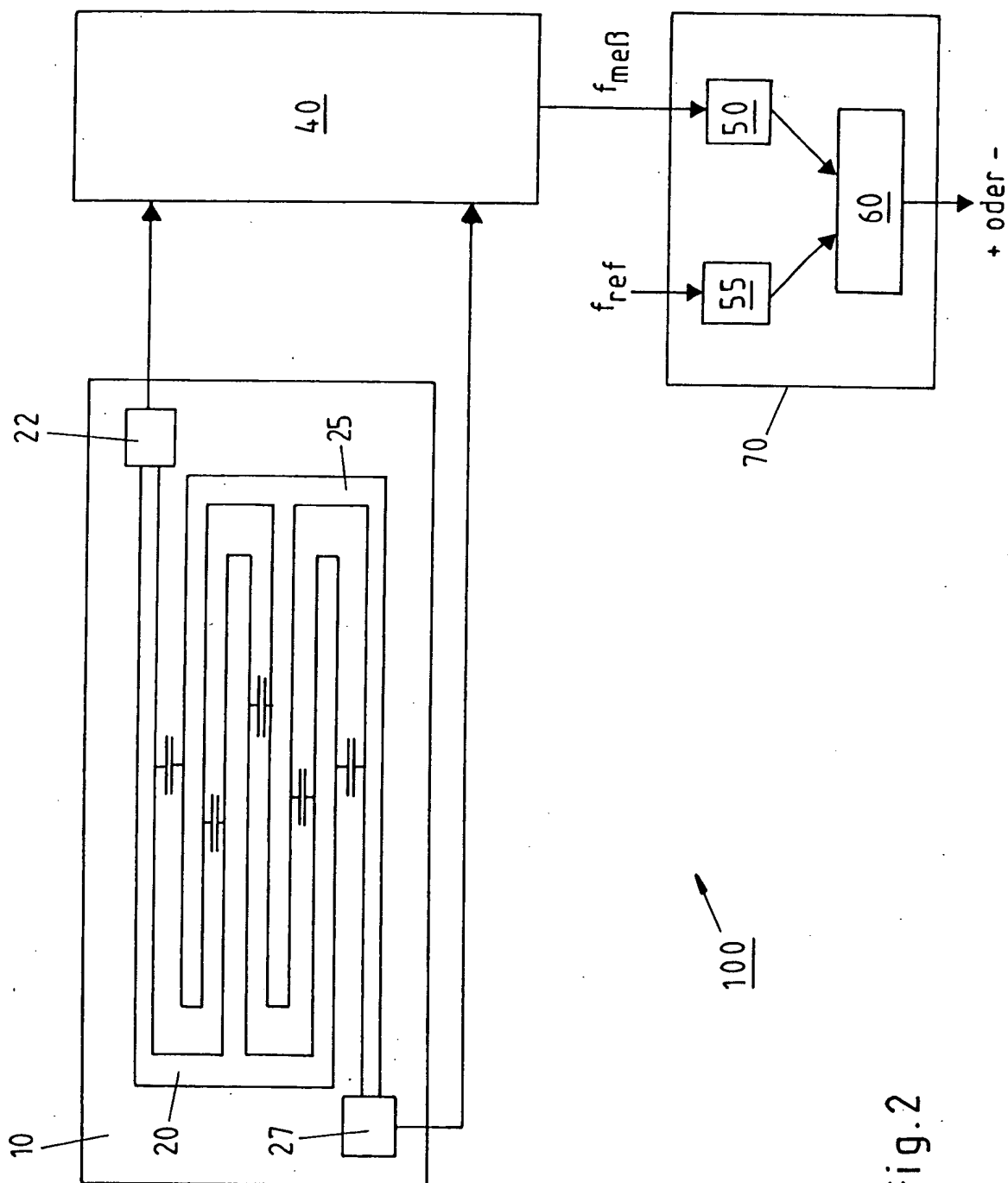


Fig.2

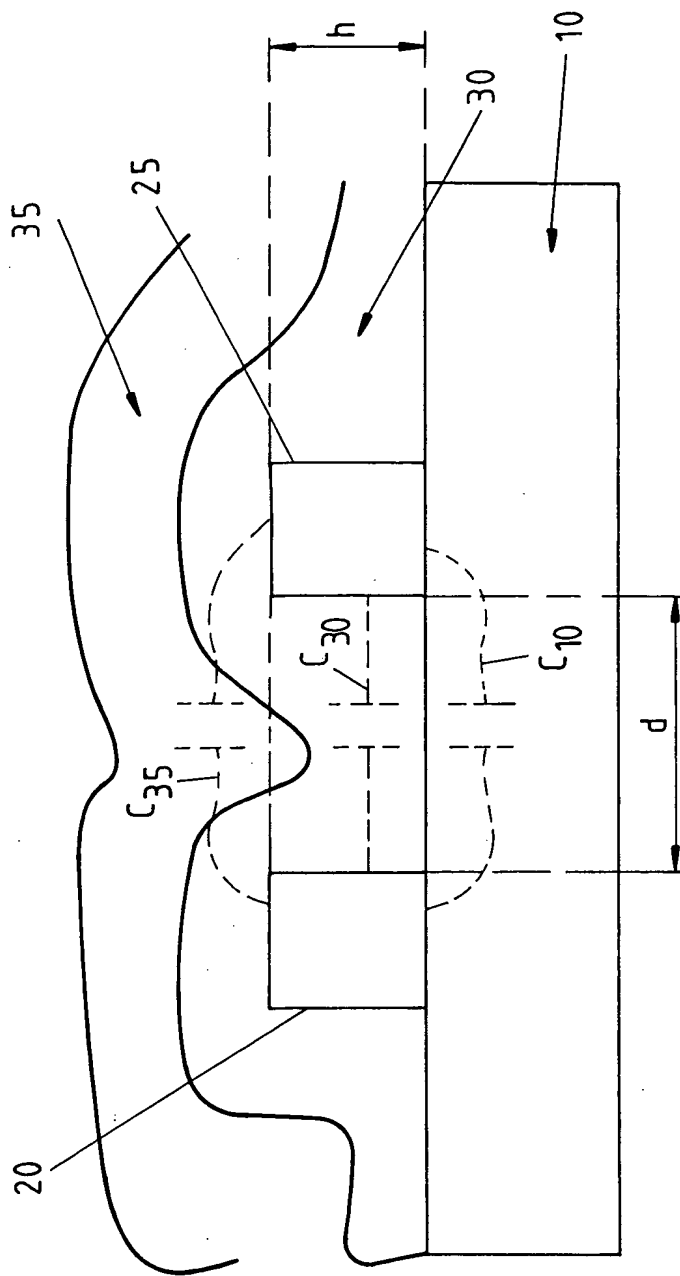


Fig.1

2/2

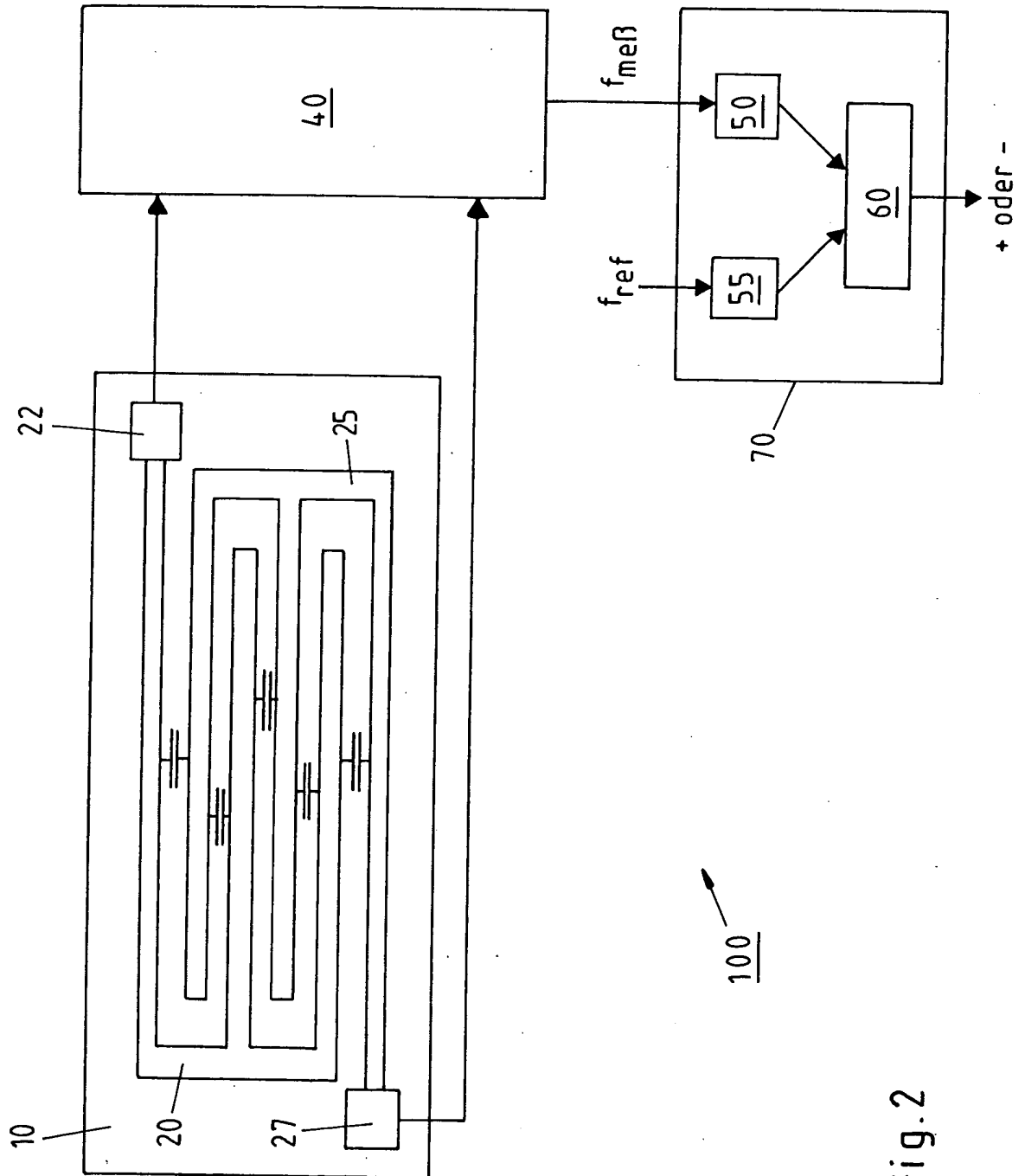


Fig.2